



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



جداسازی اپتیکی با استفاده از ساختارهای لایه‌ای حاوی لایه نقص غیرخطی

مجتبی کریمی هابیل، حمید پاشایی و صمد روشن انتظار

دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، خیابان ۲۹ بهمن، تبریز

چکیده - در این مقاله نشان می‌دهیم که بلورهای فوتونی متشکل از لایه‌های مواد مغناطیو-اپتیکی، حاوی لایه نقص غیرخطی، می‌توانند موج با قطبش دایروی راستگرد و موج با قطبش دایروی چپگرد را که به سیستم می‌تابد از همدیگر متمایز کنند. طوری که موج دایروی چپگرد با شدت فرودی مشخصی می‌تواند از این ساختار عبور کند و موج دایروی راستگرد نمی‌تواند در همان جهت از ساختار مورد نظر عبور کند، از این خاصیت می‌توان در سیستم‌های جداکننده اپتیکی تک سویه وابسته به شدت، استفاده کرد.

کلید واژه - بلور فوتونی، جداکننده اپتیکی تک سویه، قطبش دایروی، لایه نقص غیرخطی.

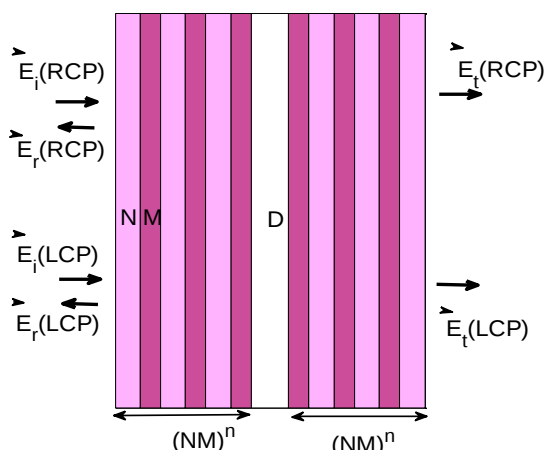
Optical isolation via layered structures containing nonlinear defect layer

Mojtaba Karimi Habil, Hamid Pashaie and Samad Roshan Entezar

Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz

Abstract-In this paper, we show that photonic crystals containing magneto-optical material layers with a nonlinear defect layer can discriminate the right-circularly polarized wave and left-circularly polarized wave impinging to the system. In the other word, the left-circularly polarized wave with particular intensity can transmit from this structure, but the right-circularly polarized wave can't transmit from this structure in the same direction. These properties may be utilized to design intensity dependent unidirectional optical isolator.

Key word- Photonic crystal, unidirectional Optical isolator, circular polarization, nonlinear defect layer.



شکل ۱- طرح شماتیک بلور فوتونی حاوی لایه نقص (D) که موج الکترومغناطیس در جهت عمود بر لایه‌ها به آن می‌تابد.

شکل ۱ ساختار بلور فوتونی را نشان می‌دهد که دارای ساختار $(NM)^n D (NM)^n$ می‌باشد، که در آن N لایه دی‌الکتریک همسانگرد و غیر مغناطیسی (SiO_2) و M لایه مغناطیسی $(Ce:YIG)$ که تانسور دی‌الکتریک آن به صورت زیر می‌باشد [۹]:

$$\hat{\epsilon}_M = \begin{bmatrix} \epsilon_1 & -ig & 0 \\ ig & \epsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

که در آن g ضریب ژیرومغناطیس، که با میدان مغناطیسی خارجی متناسب است. مقدار این ضریب برای مواد مختلف متفاوت است و به مکانیسم برهمکنش میدان مغناطیسی با محیط بستگی دارد. این ضریب را می‌توان با برازش داده‌های تجربی حاصل از اسپکتروسکوپی مغناطی ایتیکی بدست آورد. موج با قطبش خطی را می‌توان به صورت دو موج با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد در نظر گرفت که ضریب شکست لایه مغناطیسی برای این دو نوع قطبش

$$n_{\pm} = \sqrt{\epsilon_1 \pm g} \quad (2)$$

است (+ برای قطبش دایروی راستگرد و - برای قطبش دایروی چپ گرد). به طوری که از رابطه (2) دیده می‌شود، وجود عناصر غیر قطری باعث تفاوت ضریب شکست برای دو موج دایروی راستگرد و چپگرد می‌شوند [۹]. همچنین در شکل ۱ D لایه نقص غیر خطی که ضریب شکست آن به صورت

$$\epsilon_{NL} = \epsilon_L + \alpha |E_i|^2 \quad (3)$$

۱- مقدمه

انتشار نور در یک محیط به صورت یک سویه در طراحی وسایل ایتیکی از قبیل جداکننده‌های ایتیکی و انتشار دهنده‌های دایروی، که می‌توانند اثرات ناخواسته موج برگشتی را حذف کنند همواره مورد توجه بوده است. یک راه مرسوم برای دستیابی به این امر استفاده از مواد مغناطیسی می‌باشد، که در حضور میدان مغناطیسی خارجی می‌توانند باعث جداسازی موج با قطبش دایروی راستگرد و موج با قطبش دایروی چپگرد شوند، اگر چه خاصیت مغناطیسی مواد هم چون (BIG) در فرکانسهای ایتیکی بسیار کم است و این امر باعث افزایش اندازه وسایل ایتیکی می‌شود [۱و۲]. امروزه با بکار بردن لایه‌های مغناطیسی در بلورهای فوتونی ساختارهایی برای چرخش صفحه قطبش موج خطی و همچنین سیستمهای انعکاسی یک طرفه، پیشنهاد شده است [۳-۵].

ضریب شکست برخی از مواد به شدت میدان فرودی به آنها وابسته است و با تغییر شدت موج فرودی ضریب شکست آنها تغییر می‌کند. یکی از آثار ضریب شکست وابسته به شدت، دوپاداری ایتیکی است که در این پدیده وقتی موج به محیط غیرخطی می‌تابد، به ازای یک شدت ورودی دو شدت خروجی پایدار حاصل می‌شود. در دو پایداری ایتیکی میزان انتقال امواج از محیط می‌تواند با افزایش شدت فرودی از یک مقدار پایین به یک مقدار بالا به ناگاه تغییر کند که به آن شدت آستانه گفته می‌شود [۶و۷]. در این مقاله با بکار بردن لایه نقص غیرخطی و با بکار بردن لایه‌های مغناطیسی در بلورهای فوتونی، سیستمی تک سویه برای عبور موج دایروی چپگرد ارائه می‌دهیم.

۲- تئوری و ساختار مورد استفاده

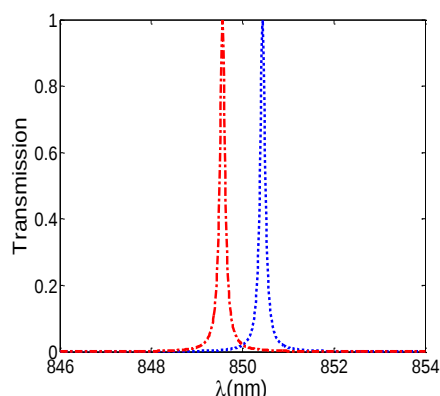
هنگامی که موج الکترومغناطیس به بلور فوتونی که دارای لایه نقص است می‌تابد، طول موج‌های خاصی واقع در گاف باند ساختار موج تقریباً به طور کامل عبور می‌کنند که این طول موجها را مد نقص می‌نامند. جایگاه مد نقص در ساختار باند به خواص ایتیکی لایه نقص و سایر لایه‌ها بستگی دارد [۸].

$$\varepsilon_M = 4.88, \mu_M = 1, d_M = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_1}} \quad (4)$$

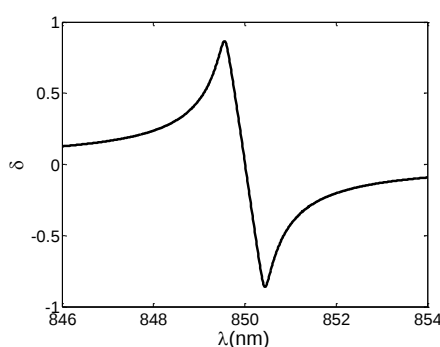
$$g = 0.05$$

ضخامت لایه D چنان انتخاب شده که راه نوری برای این لایه برابر با $\frac{\lambda_0}{2}$ است. ابتدا فرض می‌کنیم که ضریب شکست لایه D به شدت میدان الکتریکی وابسته نیست و مقدار $\varepsilon_L = 3$ انتخاب می‌کنیم.

شکل ۲ میزان تراگسیل بر حسب طول موج برای ساختار شکل ۱ را نشان می‌دهد، ملاحظه می‌شود که در نزدیکی طول موج λ_0 دو قله دیده می‌شود.



شکل ۲: میزان تراگسیل بر حسب طول موج برای ساختار شکل ۱ به ازای $n = 7$. موج عبوری با قطبش دایروی چپ گرد (منحنی خط-نقطه)، قطبش دایروی راست گرد (منحنی نقطه چین).



شکل ۳: مقدار پارامتر δ بر حسب طول موج برای ساختار شکل ۲.

برای تحلیل این دو مد، پارامتر δ را به صورت

$$\delta = \frac{T_L - T_R}{T_L + T_R} \quad (10)$$

تعریف می‌کنیم که بیانگر قطبش موج عبوری است. شکل ۳ مقدار پارامتر δ را برای موج عبوری نشان می‌دهد، ملاحظه می‌شود که به ازای طول موج $\lambda_L = 849.6 \text{ nm}$ مقدار $\delta = 0.88$ می‌رسد، و این

به شدت میدان الکتریکی موج فرودی وابسته است، که در آن ε_L ضریب شکست خطی لایه نقص و α ضریب غیر خطیت این لایه می‌باشد [۶].

فرض می‌کنیم موج الکترومغناطیس با قطبش خطی به طور عمود به بلور فوتونی شکل ۱ می‌تابد، این موج را می‌توان به صورت ترکیبی از امواج با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد در نظر گرفت که میدان الکتریکی آنها به صورت زیر است:

$$\vec{E}_i^{RCP}(z) = E_i \exp(i\beta_{(+)} z)(\hat{x} + i\hat{y}) \quad (4)$$

$$\vec{E}_t^{RCP}(z) = E_t \exp(i\beta_{(+)} z)(\hat{x} + i\hat{y}) \quad (5)$$

$$\vec{E}_r^{RCP}(z) = E_r \exp(-i\beta_{(-)} z)(\hat{x} - i\hat{y}) \quad (6)$$

$$\vec{E}_i^{LCP}(z) = E_i \exp(i\beta_{(-)} z)(\hat{x} - i\hat{y}) \quad (7)$$

$$\vec{E}_t^{LCP}(z) = E_t \exp(i\beta_{(-)} z)(\hat{x} - i\hat{y}) \quad (8)$$

$$\vec{E}_r^{LCP}(z) = E_r \exp(-i\beta_{(+)} z)(\hat{x} + i\hat{y}) \quad (9)$$

با استفاده از معادلات ماکسول برای لایه‌های دی‌الکتریک و لایه‌های مغناطیوپتیک با تانسور دی‌الکتریک رابطه (1) می‌توان ماتریس انتقال برای لایه‌های بلور فوتونی را محاسبه کرد و با استفاده از ماتریس انتقال، ارتباط بین موج فرودی و موج عبوری را برای قطبش دایروی راستگرد و چپگرد را بدست آورد، از آنجا میزان تراگسیل سیستم را محاسبه کرد [۳ و ۱۰].

۳- بحث و نتایج

به طور کلی طول موج در ناحیه مادون قرمز نزدیک، در زمینه ارتباطات نوری کاربرد بسیاری دارد، در این مقاله طول موج $\lambda_0 = 850 \text{ nm}$ برای بررسی نتایج انتخاب کرده‌ایم. فرض می‌کنیم که موج الکترومغناطیس با طول موج λ_0 به طور عمود بر لایه‌ها، به بلور فوتونی شکل ۱ می‌تابد. حالتی را در نظر می‌گیریم که در ساختار شکل ۱ $n = 7$ است و خواص اپتیکی لایه دی‌الکتریک N به صورت زیر است [۱۱]:

$$\varepsilon_N = 2.24, \mu_N = 1, d_N = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_N}} \quad (3)$$

و برای لایه مغناطیوپتیک عناصر تانسور دی‌الکتریک (2) به صورت زیر می‌باشد [۱۰]:

سیستم به عنوان یک سیستم تک سویه عمل می کند که فقط موج با قطبش خاص را در یک جهت عبور می دهد.

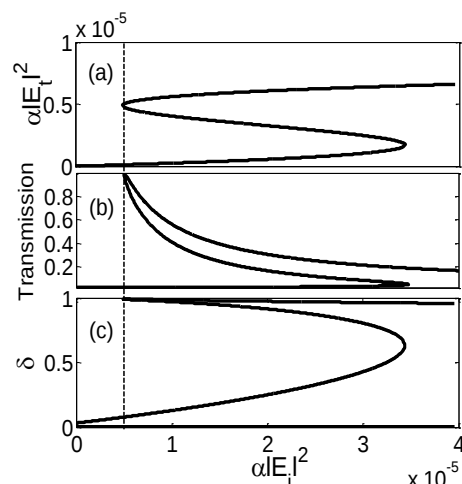
۴- نتیجه گیری

با بکار بردن لایه نقص غیر خطی در بلورهای فوتونی حاوی لایه های مغناطیوپتیک، می توان سیستمی طراحی کرد که موج با قطبش دایروی خاص را در طول موج مشخصی با شدت معین عبور دهد به طوری که سیستم می تواند به عنوان یک سیستم تک سویه عمل کند، این خاصیت می تواند در سیستم های جداکننده اپتیکی تک سویه وابسته به شدت، استفاده شود.

مراجع

- [1] N. Adachi, V. P. Denysenkov, S. I. Khartsev, A. M. Grishin, and T. Okuda, "Epitaxial Bi3Fe5O12(001) films grown by pulsed laser deposition and reactive ion beam sputtering techniques," *J. Appl. Phys.* 88(2000)2734-2739
- [2] T. Tepper and C. Ross, "Pulsed laser deposition and refractive index measurement of fully substituted bismuth iron garnet films," *J. Cryst. Growth* 255(2003) 324-331.
- [3] S. Sakaguchi and N. Sugimoto, "Transmission properties of multilayer films composed of magneto-optical and dielectric materials" *J. Lightwave Technol.* 17(1999) 1087-1092.
- [4] M. Inoue, K. I. Arai, T. Fujii, and M. Abe, "Magneto-optical properties of one-dimensional photonic crystals composed of magnetic and dielectric layers" *J. Appl. Phys.* 83(1998) 6768-6770.
- [5] M. J. Steel, M. Levy, and R. M. Osgood, "High transmission enhanced Faraday rotation in one-dimensional photonic crystals with defects," *IEEE Photon. Technol. Lett.* 12(2000)1171-1173.
- [6] R. W. Boyd "Nonlinear Optics" **Rochester University, Second Edition** (2003).
- [7] Xia Li, Kang Xie, Hai-Ming Jiang "properties of defect mode in one-dimensional photonic crystal containing tow nonlinear defects", *Optics Communications*, 282 (2009) 4292-4295.
- [8] S. Ya. Vetrov and A. V. Shabanov "Localized Electromagnetic Modes and Transmission Spectrum of a One-Dimensional Photonic Crystal With Lattice Defects", *J. Exp. and Theo. Phy.* 93(2001)977-984.
- [9] M. Levy, A. A. Jalali, X. Huang "Magnetophotonic crystals: nonreciprocity, birefringence and confinement", *J. Master sci: Master Electron*, 20(2009) S43-S47.
- [10] Ruihua Zhu, SinianFu, HongyanPeng "Far infrared Faraday rotation effect in one dimensional microcavity type magnetic photonic crystals". *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* 323 (2011) 145-149
- [11] Mikhail Vasiliev, Kamal E. Alameh, Senior Member, IEEE, Vladimir I. Belotelov, Vyacheslav A. Kotov, and Anatoly K. Zvezdin "Magnetic Photonic Crystals: 1-D Optimization and Applications for the Integrated Optics Devices", *JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY*, 24(2006)2156-2162.

بیانگر این است که در این طول موج، موج عبوری تقریباً قطبش دایروی چپگرد دارد، همچنین در طول موج $\lambda_R = 850.4 \text{ nm}$ مقدار $\delta = -0.86$ که نشان می دهد که موج عبوری در این طول موج تا حد زیادی قطبش دایروی راستگرد دارد. در طول موج λ_0 مقدار $\delta = 0$ است که نشان می دهد موج عبوری دارای قطبش خطی است، اگرچه میزان تراگسیل بسیار ناچیز است. اکنون حالتی را در نظر می گیریم که لایه نقص دارای خاصیت غیرخطی است، بنابراین ضریب شکست آن مطابق رابطه (3) به شدت میدان فرودی وابسته است.



شکل ۴: (a)- مقدار شدت خروجی بدون بعد، (b)- میزان تراگسیل، (c)- مقدار پارامتر δ ، بر حسب شدت موج فرودی بی بعد. در طول موج λ_0 پارامترها همانند پارامترهای شکل ۲ می باشند. خط چین عمود، مقدار شدت آستانه پایین را نشان می دهد.

شکل ۴(a)- رفتار دوپایداری اپتیکی سیستم را نشان می دهد، مشاهده می شود که سیستم به ازای شدتهای خاصی سوئیچ می شود که در شکل شدت آستانه پایین به صورت نقطه چین نشان داده شده است. شکل ۴(b)- میزان تراگسیل بر حسب شدت فرودی نشان می دهد ملاحظه می شود که به ازای شدت آستانه پایین مقدار تراگسیل تقریباً یک است. شکل ۴(c)- مقدار پارامتر δ را بر حسب شدت موج تابشی نشان می دهد، ملاحظه می شود که مقدار δ به ازای طول موج λ_0 تقریباً برابر یک است که این مقدار بیانگر این است که موج عبوری دارای قطبش دایروی چپگرد است. بنابراین سیستم موج قطبیده دایروی چپگرد را تقریباً به طور کامل عبور می دهد و شدت موج انعکاسی تقریباً صفر است یعنی موج قطبیده دایروی چپگرد در بازگشت نمی تواند از سیستم عبور کند، بنابراین